


	<h2 style="color: #E67E22;">FQD630TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD630TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD630TM.pdf 2.FQD630TM.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 11150 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD630TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	11150 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7A (Tc) 2.5W (Ta), 46W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 46W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD630TM ist neu im Original, Suche FQD630TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD630TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD630TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD6N15 FSC FQD6N15 FSC</p>	 <p>FQD630TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD630TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD6N25 FAIRCHI FQD6N25 FAIRCHI</p>
 <p>FQD6N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD630 F FQD630 F</p>	 <p>FQD630TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>	 <p>FQD6N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD5N20TF	↔ FQD5N40TM	⇒ FQD5N40TM	D FQD5N50C	⇒ FQD5N50CTF
⊕ FQD5N50CTF	⊗ FQD5N50CTM	D FQD5N50CTM	⇒ FQD5N50CTM-NL	⇒ FQD5N50TF
⊗ FQD5N50TF	⊕ FQD5N60C	⊗ FQD5N60CTF	↔ FQD5N60CTF	⇒ FQD5N60CTM
D FQD5N60CTM	⊗ FQD5P10TF	⊕ FQD5P10TF	⊗ FQD5P10TM	⇒ FQD5P10TM
⇒ FQD5P20TM	↔ FQD5P20TM	⊗ FQD630TF	⊕ FQD630TF	⇒ FQD630TM
↔ FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TF	D FQD6N25TM	⊗ FQD6N25TM	⊕ FQD6N40C
⊗ FQD6N40CTM	D FQD6N40CTM	⇒ FQD6N50CTF	↔ FQD6N50CTF	⇒ FQD6N50CTM
⊕ FQD6N50CTM	⊗ FQD6N60C	↔ FQD6N60CS	⇒ FQD6N60CTF	⇒ FQD6N60CTM
⊗ FQD6N60CTM	⊕ FQD6P25TM	⊗ FQD6P25TM	D FQD7N10L	⇒ FQD7N10LTF
↔ FQD7N10LTF	⊗ FQD7N10LTM	⊕ FQD7N10LTM	⊗ FQD7N10TF	⇒ FQD7N10TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited